P-CHANNEL ENHANCEMENT **MODE VERTICAL DMOS FET**

BS250P

ISSUE 2 - SEPT 93

FEATURES

- 45 Volt V_{DS}
- $R_{DS(on)} = 14\Omega$

E-Line **TO92 Compatible**

REFER TO ZVP2106A FOR GRAPHS

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Drain-Source Voltage	V _{DS}	-45	V
Continuous Drain Current at T _{amb} =25°C	I _D	-230	mA
Pulsed Drain Current	I _{DM}	-3	Α
Gate-Source Voltage	V_{GS}	±20	V
Power Dissipation at T _{amb} =25°C	P _{tot}	700	mW
Operating and Storage Temperature Range	T _j :T _{stg}	-55 to +150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Drain-Source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	-45			V	I _D =-100μA, V _{GS} =0V
Gate-Source Threshold Voltage	V _{GS(th)}	-1		-3.5	V	I _D =-1mA, V _{DS} =V _{GS}
Gate Body Leakage	I _{GSS}			-20	nA	VGS=-15V, V _{DS} =0V
Zero Gate Voltage Drain Current	I _{DSS}			-500	nA	V _{GS} =0V, V _{DS} =-25V
Static Drain-Source on-State Resistance (1)	R _{DS(on)}			14	Ω	V _{GS} =-10V, I _D =-200mA
Forward Transconductance (1)(2)	9 _{fs}		150		mS	V _{DS} =-10V, I _D =-200mA
Input Capacitance (2)	C _{iss}		60		pF	V _{GS} =0V, V _{DS} =-10V f=1MHz
Turn-On Time (2)(3)	t _(on)			20	ns	V _{DD} ≈-25V, I _D =-500mA
Turn-Off Time (2)(3)	t _(off)			20	ns	

Measured under pulsed conditions. Pulse width=300µs. Duty cycle ≤ 2% (2) Sample test
Switching times measured with a 50Ω source impedance and <5ns rise time on a pulse generator

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru_6 moschip.ru 4 moschip.ru 9